

TEM・SEMによる 有機EL(OLED)・ゲート酸化膜の断面観察

低加速STEM観察により、低密度な膜でもコントラストがつかます

測定法 : TEM・SEM

製品分野 : LSI・メモリ・ディスプレイ・太陽電池・照明

分析目的 : 形状評価・膜厚評価

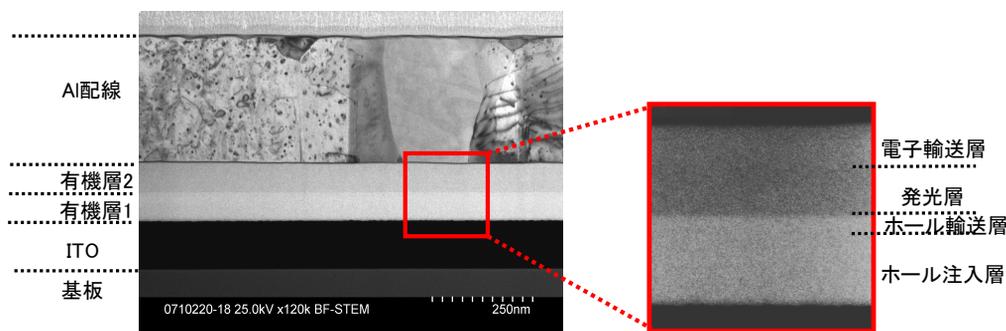
概要

密度が低い膜について、高加速電圧(数百kV)では電子線の透過能が高いためにコントラストをつけることは困難ですが、低加速電圧のSEM-STEM¹⁾像では、わずかな密度の違いを反映し、組成コントラストをはっきりつけることができます。密度差・平均質量差・組成差が小さい有機EL膜・Low-k膜・ゲート酸化膜・TEOS膜・BPSG膜などに適用できます。

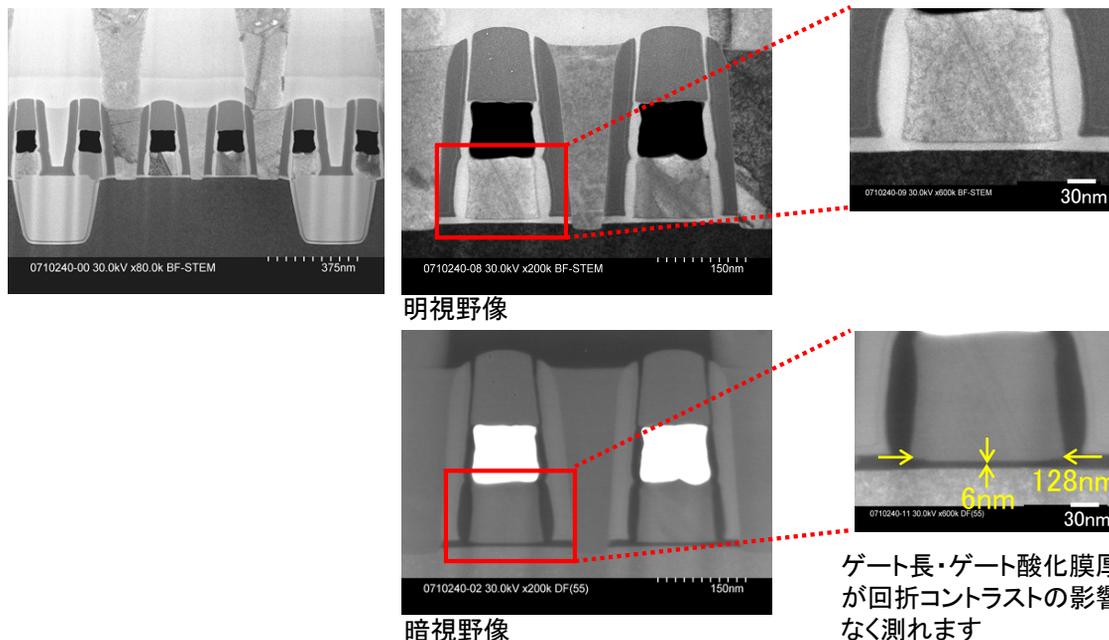
1) TEM専用機に比べて加速電圧が低いSEM装置によるSTEM観察

データ

■有機ELの断面観察：加速電圧 25kV



■メモリーの断面観察：加速電圧 30kV



分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

一般財団法人
MIST 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp
URL : <https://www.mst.or.jp/>